

## FDTシリーズ

特長

- 超小型高耐圧品(コアサイズ 8mm)
- 低リークインダクタンス
- 低入出力間容量

共通仕様

絶縁耐圧	AC2000V(1分間)
動作温度範囲	-10°C~+70°C
保存温度範囲	-20°C~+105°C



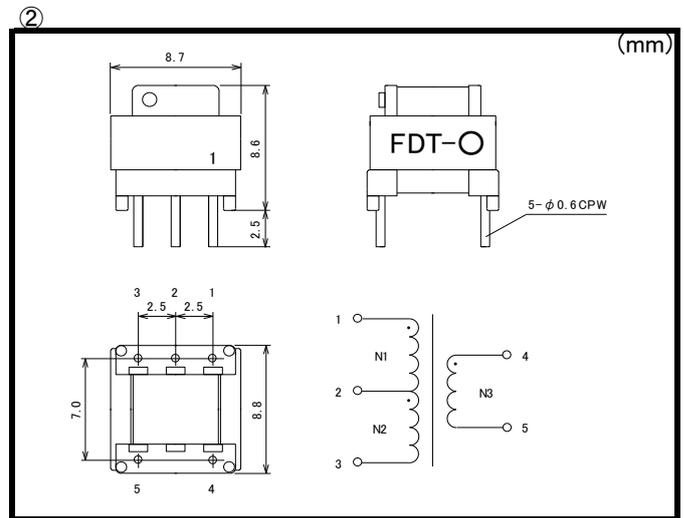
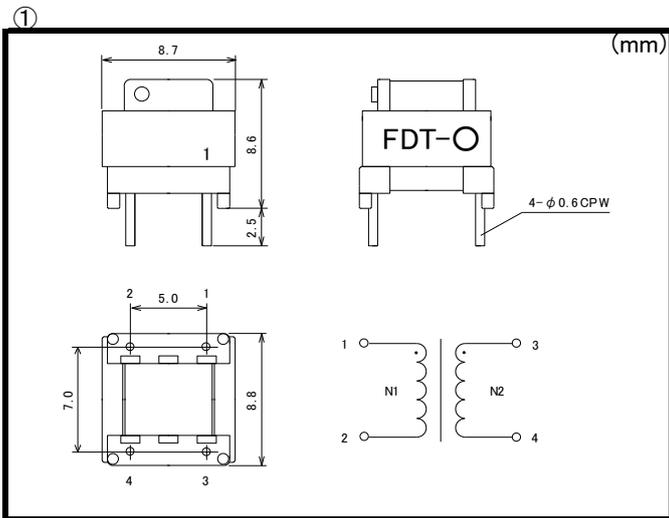
用途

- パワーMOSFET&IGBT駆動回路
- 高耐圧信号絶縁 (フィードバック用途等)
- DC-DCコンバータ回路
- 信号伝送回路
- そのほか高耐圧・小型が要求される回路

電気的特性 (Ta = 25 °C)

型名	巻き線比 N1:N2 ±5%	一次インダクタンス (mH) Min. at 1kHz	リークインダクタンス N1 (μH) Max. at 1kHz	1次-2次静電容量 (pF) Max.	直流抵抗 <1次> (Ω)Max.	直流抵抗 <2次> (Ω)Max.	立上り時間 (ns) Max. RL=50Ω	ET積 (V・μs) Min.	2次許容電流 (mA) Max. Duty = 0.5	小信号帯域	寸法図及び結線図
FDT-1	1:1	1.0	15	16	0.55	0.7	85	100	125	60kHz~400kHz	①
FDT-2	1:1	4.7	50	18	2.0	2.5	650	210	75	30kHz~200kHz	①
FDT-3	1:1	10	95	18	4.0	5.0	1200	300	55	25kHz~100kHz	①
FDT-7	1:1:1	0.047	30	16	0.25	0.3	35	50	175	90kHz~2MHz	②
FDT-8	1:1:1	0.2	90	18	0.85	1.0	165	105	100	40kHz~800kHz	②
FDT-9	1:1:1	0.4	180	19	1.85	2.1	500	150	55	30kHz~500kHz	②

寸法図及び結線図



- 本カタログの内容について、弊社の許可なく転載及び複写することは禁止いたします。
- 品質保持・改良等により、予告なく定格・仕様・外形等に変更がある場合がございます。本カタログが、最新版かどうかにつきましては、弊社担当までお問い合わせください。
- カタログ製作には、最善かつ慎重を期しておりますが、誤字・脱字などにより生じた誤謬については、責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- ご不明な点がございましたら、弊社担当までお問い合わせください。